

先端パッケージ向けスパッタリング技術

2.5D高密度実装パネルレベル インターポージャーなどのバリア/シード層形成工程に適したスパッタリング装置です。

樹脂やガラス基板上にも高い密着性を確保できます。

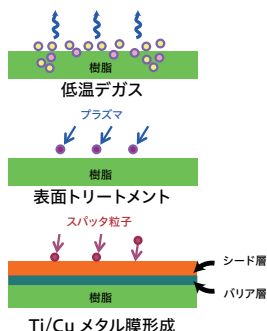
EL3400

▶▶ パネルレベルパッケージ対応スパッタリング装置

- 1 最大650mm×650mm 角基板への成膜に対応
- 2 前処理～成膜までの一貫処理
- 3 樹脂/ガラス基板上で密着性の高いシード層の形成が可能
- 4 片面成膜と両面成膜の選択が可能



バリア/シード層形成工程例



基板配置例



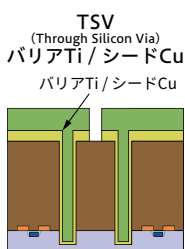
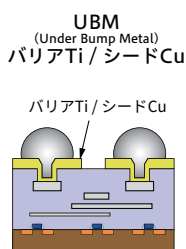
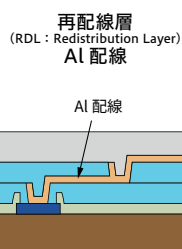
半導体前工程で培った技術を用いたウェハレベルパッケージに対応したスパッタリング装置です。

再配線層(RDL)およびバンプ下地バリア/シード層の成膜に適しています。

IC7500

▶▶ ウェハレベルパッケージ対応スパッタリング装置

- 1 前工程レベルの低パーティクル / 低汚染
- 2 量産実績に基づく高稼働率
- 3 高いウェハ面内均一性



先端パッケージ向け常温接合技術

ヘテロジニアスインテグレーションに適した接合装置です。
常温、無加圧で異種材料の強固な接合が可能です。

BC7300

ウェハ接合装置（原子拡散接合）

- 1 8インチ、12インチ基板に対応した
— ウェハ接合装置
- 2 常温での低ダメージ / 低ひずみ接合
- 3 透明 / 絶縁膜を用いた、
— フォトニクスデバイスの接合
- 4 真空封止と導電性の両立（MEMS対応）



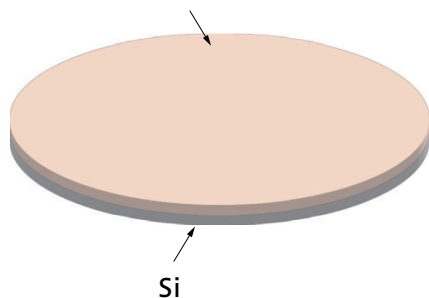
近日リリース予定

アプリケーション例

- 1 先端シリコンCMOS
— BS-PDN
— Sequential Process
- 2 先端シリコンCMOS
— シリコンフォトニクス
— 化合物-シリコン インテグレーション
- 3 化合物 機能ウェハ
— SiC、GaN、GaAs、LT、InP -Si
- 4 MEMS

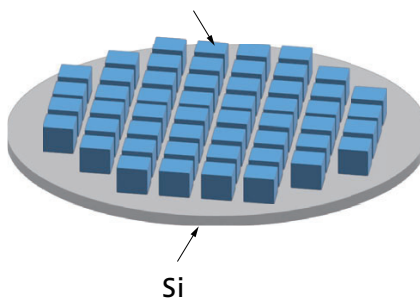
高品質の多機能デバイス
(化合物材料の低ダメージ接合)

SiC、GaN、GaAs、LT、InP



低光損失の光デバイス

化合物レーザー



パワーデバイスの放熱性向上

